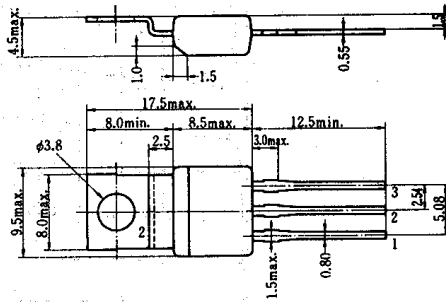


# 2SC1514

シリコン NPN 三重拡散形  
高周波高電圧増幅用  
TV 映像出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED  
HIGH FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER  
TV VIDEO OUTPUT



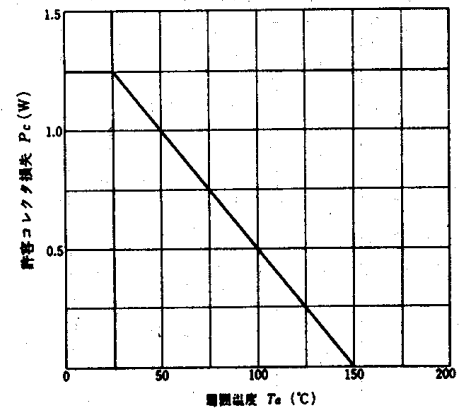
1.ベース: Base  
2.コレクタ: Collector  
3.エミッタ: Emitter  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SC1514	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	300	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	300	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_c$	100	mA
許容コレクタ損失	$P_c$	1.25	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_c=10\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_c=1.0\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=0.1\text{mA}, I_c=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_c=20\text{mA}, I_B=2.0\text{mA}$	—	—	1.5	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=20\text{V}, I_c=20\text{mA}$	30	—	200	
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_c=20\text{mA}$	50	80	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	—	4.0	pF